

## О ПОГЛОЩЕНИИ СВЕТА СТЕКЛАМИ В ДАЛЬНОЙ ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА

Л.И.Дейч

Институт физики Сибирского отделения РАН,  
660036 Красноярск, Россия

Поступила в редакцию 1 октября 1992 г.

Предложено объяснение отклонения формы кривой поглощения стекол в дальней ИК области от дебаевской.

В настоящее время общепринято, что основные особенности динамики стекол в области терагерцевых частот связаны с наличием квазилокальных колебаний (КК) <sup>1</sup>. С плотностью состояний КК связывают и появление максимума на кривой поглощения, представленной в виде  $\Gamma(\omega)/\omega^2$  ( $\Gamma$  – коэффициент поглощения,  $\omega$  – частота), в дальнем ИК диапазоне <sup>2</sup>. Однако данные по неупругому рассеянию нейтронов в  $\alpha$ -SiO<sub>2</sub> <sup>3</sup> показывают, что симметрия КК в этом материале не позволяет им быть активными в ИК поглощении <sup>2</sup>. В данной статье анализируется влияние КК на ИК спектры в такой ситуации.

В основе нашего рассмотрения лежит учет взаимодействия КК с фононами, а также ближнего и среднего порядка в пространственном распределении параметра фотон-фононной связи. Единственное отличие в выражении для поглощения по сравнению с дебаевской моделью в данном случае заключается в необходимости учета перенормировки фононной функции Грина. Если предположить, что основной вклад в поглощение вносят фононы какой-то одной из поляризаций, то можно записать для поглощения  $\Gamma(\epsilon)$ :

$$\Gamma(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon} \int c(k) \text{Im}G(\epsilon, k) d^3k, \quad (1)$$

где  $\epsilon = \omega^2$ . Эффективный параметр фотон-фононной связи  $c(k)$  пропорционален спектральной плотности  $S(k)$  неоднородностей реального параметра взаимодействия. Коэффициент пропорциональности зависит от модели этого взаимодействия и равен либо  $\text{const}$  <sup>4</sup>, либо  $k^2$  <sup>5,6</sup>.

Трактуя КК, как в <sup>7</sup>, в терминах резонансного рассеяния фононов на случайном псевдопотенциале, перенормированную функцию Грина фононов запишем в виде  $G(k) = (\epsilon - s^2 k^2 - \Sigma(\epsilon))^{-1}$ , где  $s$  – скорость звука, а массовый оператор  $\Sigma$  учитывает влияние КК. Мы пренебрежем его действительной частью, а мнимую запишем в виде:  $\text{Im}\Sigma = \epsilon\xi(\epsilon)$ , где  $\xi$  следуя <sup>7</sup> будем считать равной  $\xi = \rho\xi^{5/2}$ .

Для того чтобы получить общее представление о поведении интеграла (1) удобно рассмотреть сначала его асимптотики для специального случая функции  $c_0(k)$ , которая ведет себя как  $k^2$  при  $k \ll k_c$  и убывает быстрее чем  $k^{-2}$  при  $k \gg k_c$  ( $k_c$  характеризует масштаб неоднородностей  $\tau_c \approx k_c^{-1}$ ). В этом случае нетрудно получить:

$$\frac{A(\epsilon)}{\epsilon} = \begin{cases} c_0(k) + a_0\sqrt{\epsilon}\xi & \epsilon \ll \epsilon_c = s^2 k_c^2, & \xi \ll 1 \\ c_0(k) + a_\infty \xi \epsilon^{-3/2} & \epsilon \gg \epsilon_c, & \xi \ll 1 \\ a_\infty \xi^{-1} \epsilon^{-3/2} & \epsilon \gg \epsilon_c, & \xi \gg 1 \end{cases}, \quad (2)$$

где мы предположили, что  $\epsilon_c$  лежит в области слабого рассеяния  $\xi \ll 1$ . Теперь мы можем получить аналогичные выражения для двух других типов функций  $c(k)$ :  $c_1(k)$ , которая  $\propto \text{const}$  при  $k \ll k_c$  и убывает быстрее чем  $k^{-2}$  при  $k \gg k_c$  и  $c_2(k)$ , которая  $\propto k^2$  при малых  $k$  и  $\propto \text{const}$  при  $k \gg k_c$ :

$$\frac{A(\epsilon)}{\epsilon} = c_{1(2)}(k) + \left\{ \begin{array}{l} \mp a_0^{1(2)} \sqrt{\epsilon} \xi \quad \epsilon \ll \epsilon_c \\ \pm a_\infty^{1(2)} \xi \epsilon^{-3/2} \quad \epsilon \gg \epsilon_c \end{array} \right\} \xi \ll 1, \quad (3)$$

где верхние знаки относятся к  $c_1(k)$ , а нижние — к  $c_2(k)$ . В качестве нетривиального факта следует отметить, что КК в рассматриваемой ситуации могут давать отрицательный вклад в поглощение. В области сильного рассеяния асимптотика кривой поглощения для функций типа  $c_2$  имеет вид

$$\frac{\Gamma(\epsilon)}{\epsilon} \approx (1 + \xi^2)^{1/4} \cos(1/2 \arctg \xi), \quad (4)$$

а в случае функций  $c_1$  поглощение в этом предельном случае ведет себя также как и для  $c_0$ .

Полученные результаты позволяют провести более детальное исследование кривой поглощения. Для этого удобно выбрать функцию  $c(k)$  в виде

$$c_{SHL}(k) = (1 - z^{-3})^{-1} [z S_0(k/z) - z^{-3} S_0(k)], \quad (5)$$

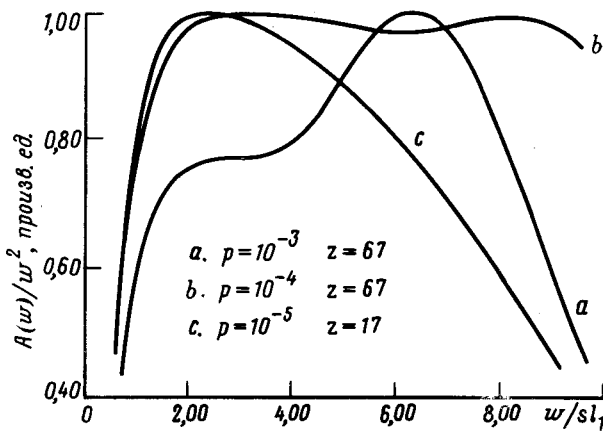
где  $S_0$  считается функцией типа  $c_1$ . Эта функция характеризуется двумя корреляционными радиусами  $r_1$  и  $r_2$ ,  $z = r_1/r_2 \geq 1$  и может рассматриваться как обобщение функции Шлеманна, которую он использовал для описания экспериментальных результатов в модели заряженных дефектов <sup>4</sup>. Последняя получается из (5) в пределе  $r_2 \Rightarrow 0$ . Использование этой функции удобно тем, что в зависимости от величины параметра  $z$  можно получить различные виды кривых поглощения, характерные для каждой из введенных выше функций  $c$ . Кроме того, учет  $r_2 \neq 0$  означает учет ближнего порядка, что является вполне естественным с физической точки зрения и оказывается чрезвычайно важным для рассматриваемой проблемы.

Используя формулы (2) – (4) можно получить любую асимптотику кривой поглощения для функции  $c_{SHL}$ , однако наибольший интерес представляет промежуточная асимптотика  $sr_1^{-1} \ll \omega \ll sr_2^{-1}$  ( $\xi \ll 1$ ), которая имеет вид

$$\frac{A(\epsilon)}{\epsilon} \propto c_{SHL}(k) - \xi (a_\infty \epsilon^{-3/2} + z^{-1} a_0 \sqrt{\epsilon}). \quad (6)$$

Видно, что учет ближнего порядка привел к появлению в (6) отрицательного вклада, быстро растущего с частотой. При определенных условиях этот член может привести к появлению максимума на кривой  $A(\epsilon)/\epsilon$ .

Для получения численных оценок мы вычислили кривую поглощения с использованием функции  $c_{SHL}(k)$ , где  $S_0$  была выбрана в виде соответствующей экспоненциальной корреляционной функции. На рисунке изображена зависимость функции  $A(\epsilon)/\epsilon^2$  от нормированной частоты  $\omega/sr_1^{-1}$ . В зависимости от параметра  $z$  мы нашли два типа кривых поглощения. При  $z \leq 20 A(\epsilon)/\epsilon^2$  имеет один максимум, лежащий в области слабого рассеяния  $\xi \ll 1$  (кривая  $c$ ). Его положение определяется главным образом корреляционным радиусом  $r_1$ . При увеличении параметра  $p$  и уменьшении  $z$  этот максимум становится все более резким. При  $z \geq 20$  могут появиться два максимума: один по-прежнему



Различные виды кривых поглощения  $\Gamma(\epsilon)/\epsilon$  для функции  $c_{SHL}(k)$

в области слабого рассеяния, а второй при  $\xi \gg 1$  (кривая *b*). Форма кривой в окрестности первого максимума может быть описана выражением (6), а его положение определяется как обоими корреляционными радиусами, так и параметром  $p$ . При увеличении  $p$  и  $z$  он становится более пологим пока не исчезает совсем (кривая *a*). Положение второго максимума определяется выражением  $\omega_m \cong sr_2^{-1}\xi^{-1}(\omega_m)$ , с увеличением  $p$  он сдвигается в сторону более низких частот, становясь при этом более ярко выраженным.

В качестве иллюстрации мы оценили величины  $r_{1(2)}$  и  $\xi(\omega_m)$  для кривой *b* используя экспериментальные данные <sup>2</sup> и наши результаты. Для корреляционных радиусов мы получили вполне приемлимые цифры 100 и 1,4Å для среднего и ближнего порядка, соответственно. Параметр  $\xi(\omega_m)$  оказался примерно 0,025, в то время как оценка этой же величины по результатам измерения теплопроводности <sup>8</sup> дала примерно 0,006.

Таким образом, предложенная в данной работе теория поглощения дальнего ИК излучения аморфным SiO<sub>2</sub> приводит к разумным оценкам основных параметров и позволяет объяснить как КК влияют на кривую поглощения в ситуации, когда они не взаимодействуют со светом непосредственно и их плотность состояний не дает прямого вклада в поглощение. Отметим также, что качественно наши результаты не изменятся при выборе другой достаточно быстро возрастающей функции  $\xi(\epsilon)$ .

1. Yu.M.Galperin, V.G.Karpov, and V.I.Kozub, Adv. Phys. **38**, 669 (1989).
2. L.Ghivelder and W.A.Phillips, J. Non. Cryst. Sol. **109**, 280 (1989).
3. U.Buchenau, M.Prager et al. Phys. Rev. **B34**, 5665 (1986).
4. E.Schlömann, Phys. Rev. **A135**, 413 (1964).
5. E.Whalley, J. of The Chem. Soc. Faraday Transactions II **68**, 662 (1972); D.D.Klug and E.Whalley, Physica A **156**, 376 (1989).
6. L.I.Deich and V.A.Ignatchenko, Waves in Random Media **1**, 133 (1991).
7. Ю.М.Гальперин, В.Г.Карпов, В.Н.Соловьев, ЖЭТФ, **94**, 373 (1988).
8. J.E.Graebner, B.Golding, and L.C.Allen, Phys. Rev. **B34**, 5696 (1986).